

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/JP01/03101

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C30B29/06, H01L21/20, 21/205, 21/322

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C30B29/06, H01L21/20, 21/205, 21/322

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
 Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001
 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
 CAS ONLINE, JICST FILE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	JP, 2000-344598, A (Nippon Steel Corporation), 12 December, 2000 (12.12.00), Claims 1 to 7 (Family: none)	1-14
EX	JP, 2001-102385, A (Mitsubishi Materials Silicon Corporation), 13 April, 2001 (13.04.01), Claim 1; Par. Nos. [0018], [0024]; table 1; Figs. 1, 3 (Family: none)	1, 3-5
A	TAKEDA R. et al., "Dissolution behavior of COP in hydrogen annealed wafer I. Effect of COP size", 2000nen Shunki Dai 47kai, Oyou Butsurigaku Kankei Rengou Kouenkai Kouen Yokoushuu, Separate Vol. 1, 28 March, 2000 (28.03.2000), page 432, 30p-YM-9	1, 3-5

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

"A"	Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E"	earlier document but published on or after the international filing date	"X"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&"	document member of the same patent family
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		

Date of the actual completion of the international search
26 June, 2001 (26.06.01)Date of mailing of the international search report
03 July, 2001 (03.07.01)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.



(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001年10月25日 (25.10.2001)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 01/79593 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C30B 29/06, H01L 21/20, 21/205, 21/322
- (21) 国際出願番号: PCT/JP01/03101
- (22) 国際出願日: 2001年4月10日 (10.04.2001)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2000-113297 2000年4月14日 (14.04.2000) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 信越半導体株式会社 (SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目4番2号 Tokyo (JP).

Makoto) [JP/JP]. 木村雅規 (KIMURA, Masanori) [JP/JP]; 〒379-0196 群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越半導体株式会社 半導体磯部研究所内 Gunma (JP).

(74) 代理人: 好宮幹夫 (YOSHIMIYA, Mikio); 〒111-0041 東京都台東区元浅草2丁目6番4号 上野三生ビル4F Tokyo (JP).

(81) 指定国(国内): JP, KR, SG, US.

(84) 指定国(広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

添付公開書類:
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドノート」を参照。

- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 飯田 誠 (IDA,

(54) Title: SILICON WAFER, SILICON EPITAXIAL WAFER, ANNEAL WAFER AND METHOD FOR PRODUCING THEM

(54) 発明の名称: シリコンウエーハ、シリコンエピタキシャルウエーハ、アニールウエーハならびにこれらの製造方法

(57) Abstract: A method for producing a silicon single crystal in which a silicon single crystal being grown by the Czochralski method is doped with carbon and nitrogen method and the crystal is pulled up under control such that an N region occupies the entire surface of the crystal, and a silicon wafer having an N region doped with carbon and nitrogen over the entire surface. A technology for growing a silicon single crystal having a high IG capability at a high rate and having little glow-in defects is thereby developed and a silicon wafer having a high IG capability in the N region over the entire surface of the crystal, or an epitaxial wafer or anneal wafer having excellent crystallinity and IG capability is provided.

(57) 要約:

本発明は、チョクラルスキ法によりシリコン単結晶を育成する際に、炭素および窒素をドープし、結晶全面がN-領域となるように制御しながら結晶を引上げるシリコン単結晶の製造方法、および炭素と窒素がドープされた全面N-領域からなるシリコンウエーハである。これによりグローンイン欠陥が少ないとともに、IG能力の高いシリコン単結晶を、高速で成長させることを可能とするシリコン単結晶育成技術を開発し、結晶全面N-領域でIG能力の高いシリコンウエーハ、あるいは優れた結晶性とIG能力を有するエピタキシャルウエーハ、アニールウエーハが提供される。

WO 01/79593 A1

$\Delta_{\text{eff}} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right)_{x=0}$ is the effective diffusivity at the center of the cylinder.

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{eff}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right)_{x=0} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} \sin(2\pi x) \right) \right)_{x=0} \\ &= \frac{1}{2} \left(2x - 2\pi \cos(2\pi x) \right)_{x=0} = \frac{1}{2} (0 - 2\pi) = -\pi \end{aligned}$$

Thus, the effective diffusivity is $\Delta_{\text{eff}} = -\pi$.

Thus, $\Delta_{\text{eff}} = -\pi$.

明 細 書

シリコンウエーハ、シリコンエピタキシャルウエーハ、
アニールウエーハならびにこれらの製造方法

5

技術分野

本発明は、CZシリコン単結晶に対してドープした炭素および窒素の影響を有効に利用した高品質のシリコンウエーハ、エピタキシャルウエーハおよびアニールウエーハならびにこれらの製造方法に関する。

背景技術

デバイスプロセスの高集積化・微細化に伴い、ベースとなるシリコンウエーハのグローンイン (Grown-in) 欠陥の低減が強く要求されている。そこで、チョクラルスキイ (Czochralski; CZ) 法により製造されたCZシリコン単結晶の成長条件を改良して開発された、全面N (ニュートラル) - 領域ウエーハや、通常のシリコンウエーハ上に新たにシリコンを成長させたシリコンエピタキシャルウエーハ (以下、エピタキシャルウエーハ或いはエピウエーハと言うことがある)、そして、水素やアルゴン雰囲気中で高温熱処理を施したアニールウエーハ等、グローンイン欠陥の少ない数種類のウエーハが開発されている。

ここで、全面N-領域ウエーハの製造方法について説明しておく。

先ず、シリコン単結晶に取り込まれるベイカンシイ (Vacancy、以下Vと略記することがある) と呼ばれる空孔型の点欠陥と、インタースティーシアルシリコン (Interstitial-Si、以下Iと略記することがある) と呼ばれる格子間型シリコン点欠陥のそれぞれの取り込まれる濃度を決定する因子について、一般的に知られていることを説明する。

シリコン単結晶において、V-領域とは、Vacancy、つまりシ

リコン原子の不足から発生する凹部、穴のようなものが多い領域であり、
I-領域とは、シリコン原子が余分に存在することにより発生する転位
や余分なシリコン原子の塊が多い領域のことであり、そしてV-領域と
I-領域の間には、原子の不足や余分が無い（少ない）ニュートラル領
域（Neutral領域、以下N-領域と略記することがある）が存在
していることになる。そして、前記グローンイン欠陥（F P D、L S T
D、C O P等）というのは、あくまでもVやIが過飽和な状態の時に発
生するものであり、多少の原子の偏りがあっても、飽和以下であれば、
欠陥としては存在しないことが判ってきた。

この両点欠陥の濃度は、C Z法における結晶の引上げ速度（成長速度）
Vと結晶中の固液界面近傍の温度勾配Gとの関係から決まることが知ら
れている。また、V-領域とI-領域との間のN-領域には、O S F（酸
化誘起積層欠陥、O x i d a t i o n I n d u s e d S t a c k i
n g F a u l t）と呼ばれるリング状に発生する欠陥の存在が確認さ
れている。

これら結晶成長起因の欠陥を分類すると、例えば成長速度が0.6 m
m / m i n 前後以上と比較的高速の場合には、空孔タイプの点欠陥が集
合したボイド起因とされているF P D、L S T D、C O P等のグローン
イン欠陥が結晶径方向全域に高密度に存在し、これら欠陥が存在する領
域はV-リッチ領域と呼ばれている。また、成長速度が0.6 mm / m
i n 以下の場合は、成長速度の低下に伴い、上記したO S Fリングが結
晶の周辺から発生し、このリングの外側に格子間シリコンタイプの点欠
陥が集合した転位ループ起因と考えられているL / D（L a r g e D
i s l o c a t i o n : 格子間転位ループの略号、L S E P D、L F P
D等）の欠陥が低密度に存在し、これら欠陥が存在する領域はI-リッ
チ領域と呼ばれている。さらに、成長速度を0.4 mm / m i n 前後以
下に低速にすると、O S Fリングがウエーハの中心に凝集して消滅し、
全面がI-リッチ領域となる。

また、最近V-リッチ領域とI-リッチ領域の中間でO S Fリングの

外側に、ボイド起因の F P D 、 L S T D 、 C O P も、転位ループ起因の L S E P D 、 L F P D も、さらには O S F も存在しない N - 領域の存在が発見されている。この領域は O S F リングの外側にあり、そして、酸素析出熱処理を施し、 X - r a y 観察等で析出のコントラストを確認した場合に、酸素析出がほとんどなく、かつ、 L S E P D 、 L F P D が形成されるほどリッチではない I - リッチ領域側である。さらに、 O S F リングの内側にも、ボイド起因の欠陥も、転位ループ起因の欠陥も存在せず、 O S F も存在しない N - 領域の存在が確認されている。

これらの N - 領域は、通常の方法では、成長速度を下げた時に成長軸方向に対して斜めにしか存在しないため、ウエーハ面内では一部分にしか存在しなかった。

この N - 領域について、ボロンコフ理論 (V. V. Voronkov; Journal of Crystal Growth, 59 (1982) 625 ~ 643) では、引上げ速度 V と結晶固液界面軸方向温度勾配 G の比である V/G というパラメータが点欠陥のトータルな濃度を決定すると唱えている。このことから考えると、面内で引上げ速度は一定のはずであるから、面内で G が分布を持つために、例えば、ある引上げ速度では中心が V - リッチ領域で N - 領域を挟んで周辺で I - リッチ領域となるような結晶しか得られなかつた。

そこで最近、面内の G の分布を改良して、この斜めでしか存在しなかつた N - 領域を、例えば、引上げ速度 V を徐々に下げながら引上げた時に、ある引上げ速度で N - 領域が横全面に広がった結晶が製造できるようになった。また、この全面 N - 領域の結晶を長さ方向へ拡大するには、この N - 領域が横に広がった時の引上げ速度を維持して引上げればある程度達成できる。また、結晶が成長するに従って G が変化することを考慮し、それを補正して、あくまでも V/G が一定になるように、引上げ速度を調節すれば、それなりに成長方向にも、全面 N - 領域となる結晶が拡大できるようになった。

また、最近ではデバイスプロセス中における不純物の影響を取り除く

ため、ゲッタリング能力の強いウェーハも要請されている。これに対し
ては、熱処理を追加したり、窒素の酸素析出促進効果を利用するためC
Z法によりシリコン単結晶引上げ中に窒素をドープしながらN-領域で
引上げた窒素ドープN-領域ウェーハや、窒素ドープしたウェーハ上に
5 エピタキシャル成長を行った窒素ドープエピタキシャルウェーハ、あるいは
窒素ドープしたウェーハにアニールを行った窒素ドープアニールウェー
ハを作製することにより、バルク中のBMD (Bulk Micro
o Defect : 酸素析出物による内部微小欠陥) 密度を増加させ、
IG (Internal Gettering) 効果を持たせたウェー
10 ハ等が開発されている。

近年、デバイスを作製するメーカーのゲッタリング能力に対する要求
は非常に強く、使用されるウェーハの付加価値としてのゲッタリング能
力は欠かせないものとなってきている。しかしながら、従来のN-領域
ウェーハ、エピウェーハおよびアニールウェーハでは、デバイスプロセ
15 ス中の酸素析出によるBMD密度は十分とはいえない。

そこで、窒素の酸素析出促進効果を利用した窒素をドープしたウェー
ハが開発された。窒素をドープすることにより、N-領域が得られる引
上速度の範囲を拡大できるので安定した結晶成長が望めるが、N-領域
ウェーハを作製するためにはその引上げ速度を0.5mm/min程度
20 に低下させなければならないことに変わりがなく、生産性の低下、コス
トアップを招いていた。

また、ドープする窒素濃度を高くするとOSF領域が拡大されたり、
その領域内に転位クラスター等の2次欠陥(以下、LEP (Large
Etch Pit)と呼ぶことがある)が発生する場合があり、これ
25 がエピタキシャル層の欠陥の元となるため、あまり高い窒素濃度を採用
できないのが現状である。そのため、窒素ドープウェーハによって得ら
れるBMD密度は窒素ノンドープウェーハに比べれば多いものの、程々
の密度に抑えられている。ここで、本発明でいう2次欠陥とは、高濃度
の窒素ドープに起因して拡大されるOSF領域に発生する欠陥であって、

その代表的なものとして転位クラスター（L E P）や転位ループが挙げられる。

さらに、窒素は高温で安定な酸素析出核を作ることが知られている（1999年春季第46回応用物理学関係連合講演会講演予稿集N o. 1, 5 p. 461, 29a-ZB-5、相原他）が、低温からの析出核形成には少しも関与しておらず、低温熱処理による酸素析出核形成の促進は期待できない等の問題点があった。

発明の開示

10 本発明は、かかる問題点を解決するためになされたもので、グローンイン欠陥が少ないとともに、IG能力の高いシリコン単結晶を、高速で成長させることを可能とするシリコン単結晶育成技術を開発し、結晶全面N一領域でIG能力の高いシリコンウェーハ、あるいは優れた結晶性とIG能力を有するエピタキシャルウェーハ、アニールウェーハを提供することを主たる目的とする。

上記課題を解決するための本発明は、チョクラルスキー法によりシリコン単結晶を育成する際に、炭素をドープし、V/G（V：結晶引上げ速度、G：結晶固液界面における結晶軸方向温度勾配）を結晶全面がN一領域となるように制御しながら結晶を引上げることを特徴とするシリコン単結晶の製造方法である。

このように炭素をドープすることによりN一領域の単結晶を、炭素ノンドープの場合よりも高速で引上げることができ、グローンイン欠陥のないシリコン単結晶の生産性の向上とコストダウンを図ることができる。

この場合、CZシリコン単結晶育成時に、炭素とともに窒素をドープすることができる。

このように炭素とともに窒素をドープすれば、N一領域となる引上げ速度が上昇するとともに、N一領域を拡大させることができるので、結晶全面がN一領域のシリコン単結晶の生産性と歩留りを同時に向上させることができる。

そしてこの場合、ドープする炭素濃度を 0. 1 p p m a 以上とし、V / G を 0. 183 ~ 0. 177 mm² / K · m i n の範囲内で制御しながら引上げることが好ましい。

5 このようにすれば、より一層安定的に高速で結晶全面Nー領域のシリコン単結晶を確実に製造することができる。

そして、本発明に係るシリコンウエーハの製造方法は、上記のような方法で製造されたシリコン単結晶をウエーハに加工した後、600 ~ 1000°Cの温度で熱処理を施すことを特徴としている。

10 このように炭素、炭素および窒素をドープした単結晶をウエーハに加工し、600 ~ 1000°Cで熱処理を施せば、ウエーハに炭素がドープされているので、バルク部では低温における酸素析出核の形成が促進され、表面は全面Nー領域であるウエーハであって、ウエーハ面内で高レベルでIG能力を有するウエーハを製造することができる。

15 また本発明のシリコンウエーハは、炭素を 0. 1 p p m a 以上含有し、全面Nー領域からなるものである。

このように、炭素を 0. 1 p p m a 以上含有することによって、低温で安定な酸素析出核が増加し、全面がNー領域であるとともに、十分なIG能力を有するシリコンウエーハとなる。

この場合、本発明のシリコンウエーハは、窒素を 1×10^{18} 個 / cm³ 以上含有することが好ましい。

このように、窒素も炭素も含有することによって、適度の酸素濃度であれば、高温熱処理でも低温熱処理でも十分に高密度のBMDを有し、IG能力の極めて高いシリコンウエーハとなる。

そして本発明に係るエピタキシャルウエーハの製造方法は、CZシリコン単結晶育成時に炭素および窒素をドープして引上げられたCZシリコン単結晶から作製されたシリコンウエーハ表面にエピタキシャル層を形成するシリコンエピタキシャルウエーハの製造方法において、CZシリコン単結晶の炭素濃度、窒素濃度、酸素濃度がそれぞれ 0. 1 ~ 1 p p m a、 $1 \times 10^{18} \sim 1 \times 10^{14}$ 個 / cm³、15 ~ 25 p p m a、ま

たは、それぞれ $1 \sim 3 \text{ ppm}$ 、 $1 \times 10^{14} \sim 5 \times 10^{15}$ 個/ cm^3 、

$10 \sim 15 \text{ ppm}$ となるようにCZシリコン単結晶を引上げることを特徴としている。

このように、エピウェーハの基板となるシリコンウェーハを得るのに、
5 上記規定内の炭素、窒素、酸素濃度になるように炭素、窒素および酸素をドープして単結晶を引上げれば、これを加工して十分なIG能力を有し、2次欠陥のないシリコンウェーハ上にエピタキシャル層を形成することができ、高品質なエピウェーハを容易に得ることができる。

さらに本発明に係るエピウェーハは、CZシリコン単結晶育成時に炭
10 素および窒素をドープして引上げられたCZシリコン単結晶から作製されたシリコンウェーハ表面に、エピタキシャル層を形成したシリコンエピタキシャルウェーハであって、シリコンウェーハ中の炭素濃度、窒素濃度、酸素濃度がそれぞれ $0.1 \sim 1 \text{ ppm}$ 、 $1 \times 10^{18} \sim 1 \times 10^{14}$ 個/ cm^3 、 $15 \sim 25 \text{ ppm}$ 、または、それぞれ $1 \sim 3 \text{ ppm}$ 、 $1 \times 10^{14} \sim 5 \times 10^{15}$ 個/ cm^3 、 $10 \sim 15 \text{ ppm}$ であることを特徴としている。

上記規定値内に炭素濃度、窒素濃度、酸素濃度を制御したシリコンウェーハを基板として、エピ層を形成したエピウェーハは、基板に2次欠陥もないのでこの上に形成されるエピ層の結晶性に優れ、高いIG能力
20 を有する極めて高品質のエピタキシャルウェーハである。

加えて本発明に係るアニールウェーハの製造方法は、CZシリコン単結晶育成時に炭素および窒素をドープして引上げられたCZシリコン単結晶から作製されたCZシリコンウェーハに熱処理を行うことにより、該CZシリコンウェーハの表層部に無欠陥層を形成し、バルク部に 1×25 10^9 個/ cm^3 以上の酸素析出物を有するアニールウェーハを製造するに際し、CZシリコン単結晶の炭素濃度、窒素濃度、酸素濃度がそれぞれ、 $0.1 \sim 1 \text{ ppm}$ 、 $1 \times 10^{18} \sim 1 \times 10^{14}$ 個/ cm^3 、 $15 \sim 25 \text{ ppm}$ 、または、それぞれ $1 \sim 3 \text{ ppm}$ 、 $1 \times 10^{14} \sim 5 \times 10^{15}$ 個/ cm^3 、 $10 \sim 15 \text{ ppm}$ となるようにCZシリコン単結

晶を引上げることを特徴とするものである。

このように、アニールウェーハの元になるシリコンウェーハを得るのに、上記規定内の炭素、窒素、酸素濃度になるように炭素および窒素をドープしてCZ法により単結晶を引上げれば、十分なBMD密度を有し、
5 2次欠陥の発生のないアニールウェーハを容易に得ることができる。

そして本発明に係るアニールウェーハは、炭素濃度、窒素濃度、酸素濃度がそれぞれ、0.1~1 ppm、 $1 \times 10^{13} \sim 1 \times 10^{14}$ 個/cm³、15~25 ppm、または、それぞれ1~3 ppm、 $1 \times 10^{14} \sim 5 \times 10^{15}$ 個/cm³、10~15 ppmであるCZシリコンウェーハに熱処理を施したアニールウェーハであって、バルク部のB
10 MD密度が 1×10^9 個/cm³以上であることを特徴としている。

このように、上記規定値内に炭素濃度、窒素濃度、酸素濃度を制御したシリコンウェーハに熱処理を施して作製したアニールウェーハは、十分に高密度のBMDを有し高いIG能力を有するとともに、ウェーハ表面に欠陥が少なく、2次欠陥もない結晶性に優れた、高品質のアニール
15 ウェーハである。

以上のように本発明によれば、面内全面N-領域で2次欠陥の発生がないとともに、高いIG能力を有する単結晶を高速で引上げができる。従って、このようなCZシリコン単結晶の生産性と歩留りの向上を
20 図ることができるとともに、生産コストを大幅に低減することができる。また、結晶位置やデバイスプロセスに依存せずに安定した酸素析出が得られるので、酸素析出物密度のバラツキが少なく安定したゲッタリング能力を有するCZシリコンウェーハを得ることができる。さらに、本発明のように炭素、窒素、酸素濃度が適切な範囲のCZシリコンウェーハ
25 を作製することにより、その表面に高温のエピタキシャル成長を行っても酸素析出が消滅することなく、結晶性に優れ、IG能力の高いエピタキシャルウェーハを製造することができる。同様にそのようなCZシリコンウェーハに熱処理を施せば、表層部に無欠陥層を形成し、バルク部に十分に高密度のBMDを有するアニールウェーハを作製することができ

でき、高集積デバイス用として極めて有用である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態について、さらに詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

本発明者等は、バルク部の酸素析出を促進させるために窒素をドープするだけでなく、炭素をドープすることを発想し、これについて調査、検討した。

10 (N-領域ウエーハについて)

先ず、N-領域ウエーハへの炭素ドープの影響を調査した。

直径8インチのCZシリコン単結晶を育成する際に、炭素が0.1ppma程度結晶に入るようにドープし、CZシリコン単結晶引上げ装置を全面N-領域ウエーハの育成可能なHZ(Hot Zone: 炉内構造)にして、引上速度を0.8~0.5mm/minに徐々に変化させて引上げを行った(窒素ドープなし)。

その結果、炭素ノンドープの際には引上速度が0.54mm/minにてOSFリングが消滅し、0.52mm/minで転位ループ起因の欠陥が発生したのに対して、炭素をドープした場合は0.65mm/minにてOSFリングが消滅し、0.63mm/minにて転位ループ起因の欠陥が発生した。つまり、炭素をドープすることによりN-領域がより高速で得られると言うことを発見した。このときの、V/Gの範囲は0.183~0.177mm²/K·minであった。これは炭素ドープによって全面N-領域ウエーハの生産性が向上することを意味する。ただし、炭素濃度が3ppmaを超えると、デバイス特性への悪影響が懸念されるので、3ppma以下にするのが好ましい。

通常N-領域には2種類あって、空孔型欠陥が優勢なV-リッチ領域側に位置するN(V)領域と、格子間シリコンが優勢な転位ループ起因の欠陥が存在する領域であるI-リッチ領域側に位置するN(I)領域

が混在しており、この2つの領域は酸素析出量が異なることが知られている（特願平11-322242号参照）。すなわち、ウエーハの面内位置や結晶からの切り出し位置によってIG能力も異なり、問題となっていた。

5 このことは、窒素ドープ結晶においても同様であった。しかし、炭素をドープした場合は、低温（600～1000°C）における酸素析出核の形成を促進することが別の実験から確認されたため（特願2000-048461号参照）、炭素をドープしたウエーハにこのような低温の熱処理を施すことにより、N(V)領域とN(I)領域との両領域の析出¹⁰の差を殆どなくすことができた。これは、炭素ドープによる全面N-領域ウエーハは、ウエーハ面内の全面が高いレベルでIG能力が安定していることを示している。

次に、炭素に加えて窒素もドープし上記と同様な実験を行った。その結果、N-領域となる引上速度は上昇するとともに拡大した。窒素はもともとN-領域の拡大効果はあったが、N-領域となる引上げ速度は上昇しなかったので、この2つのドープ剤により、全面N-領域ウエーハは生産性と歩留りを同時に向上させたことを示す。また、酸素析出に対する効果も顕著に得られ、窒素により高温で安定な酸素析出核が増加し、又炭素により低温で安定な析出核も増加した。このことは、様々な温度²⁰帯で酸素析出の促進効果が強いことを示す。従って、デバイス工程における熱処理がどのようなものであっても、高いIG能力を発揮できることになる。尚、窒素の効果を確実に得るためにには 1×10^{10} 個/cm³以上の濃度が必要であり、単結晶化の妨げにならないようにするには、 5×10^{15} 個/cm³以下とすることが好ましい。

25 これらの実験事実を考慮した上で、上記の実験と同じHZを使用して、今度は結晶の長い範囲で同様な結晶を得るために、まず炭素を0.1ppma、窒素を 3×10^{18} 個/cm³となるようにドープし、引上速度を0.65～0.62mm/minの範囲で引上げを行った。その結果、結晶の上部（種結晶側）から直胴20cmの位置より下側がN-領域と

なった。この結晶から切り出したウエーハに 600°C で 1 時間の熱処理を施して酸素析出核の形成を促進させた後、800°C / 4 Hr + 1000°C / 16 Hr の熱処理を施して酸素析出物を成長させて O P P (Optical Precipitate Profiler) 法により観察したところ、ウエーハ全面において 1×10^9 個 / cm² 以上の密度で BMD がバルク中に存在していた。

(エピタキシャルウエーハについて)

次に、エピタキシャル成長用のシリコンウエーハについて、炭素と窒素をドープした場合の BMD 密度に対する影響を調査し、実験した。

窒素濃度は 1×10^{14} 個 / cm² を越えると OSF 領域の拡大が大きく、また LEP も発生し易いため、まずは窒素濃度 5×10^{13} 個 / cm² となるようにドープし、炭素を 0.1 ppm となるようにドープして、結晶を引上げた。そして、その結晶からウエーハを作製し、800°C / 4 Hr + 1000°C / 16 Hr の熱処理を施して酸素析出物を顕在化した後に BMD 密度を O P P 法により評価した。

その結果、ウエーハ中の初期格子間酸素濃度の依存性が強く、15 ppm (日本電子工業振興協会 (JEIDA) 規格) 以上でないと BMD 密度は 10^9 台の数で発生しないことがわかった。ただし、この窒素濃度 (5×10^{13} 個 / cm²) は、窒素ドープによる 2 次欠陥は殆ど発生することなく、しかも高温 (1000°C 以上) で安定な酸素析出核が形成されるので、高温のエピタキシャル成長が行なわれても酸素析出核が消滅する事がない。従って、このように窒素濃度が 5×10^{13} 個 / cm² であり、炭素濃度が低濃度 (0.1 ppm) であっても、初期格子間酸素濃度が 15 ppm 以上であれば、十分な BMD 密度と 2 次欠陥の発生のないエピタキシャル成長用のシリコンウエーハが得られる事になる。酸素濃度が 15 ppm 以上であれば、窒素濃度は 1×10^{13} 以上あれば必要十分な BMD 密度が得られるが、酸素濃度が 25 ppm を超えると、析出過多となり、ウエーハ強度に影響を及ぼすので

25 p p m a 以下とすることが好ましい。なお、炭素による酸素析出効果を高めるために、エピタキシャル成長前に 600 ~ 1000 °C 程度の低温熱処理を加えることが好ましい。

続いて窒素高濃度 (1×10^{14} 個 / cm^3 以上) を使用するために、

5 初期格子間酸素濃度を下げたサンプルを作製した。このように、窒素濃度が高くても酸素濃度を 15 p p m a 未満に下げれば、2 次欠陥の発生を抑制することができるが、実際に酸素析出は起こりにくい結果 (BMD 密度 $< 1 \times 10^9$ 個 / cm^3) となった。

そこで、炭素濃度を 1.0 p p m a まで引上げた。すると、酸素濃度 10 が 12 p p m a という低酸素においても、800 °C / 4 H r + 1000 °C / 16 H r 後の BMD 密度は、 10^9 台前半の数は存在した。つまり、この組み合わせ (窒素濃度 1×10^{14} 個 / cm^3 、炭素濃度 1.0 p p m a) の場合は、初期酸素濃度が低酸素であれば 2 次欠陥が発生せず、そして高い BMD 密度が得られることになる。ただし、炭素濃度が 3 p 15 p m a を超えると作製されるデバイス特性に悪影響を及ぼす恐れがあるので、炭素濃度は 3 p p m a 以下が好ましい。また、十分な BMD を得るための酸素濃度は、10 p p m a 以上が必要である。窒素濃度については引上げ結晶の単結晶化の妨げにならないようにするためには、 5×10^{15} 個 / cm^3 以下にすることが好ましい。この場合も、炭素による酸素析出効果を高めるために、エピタキシャル成長前に 600 ~ 1000 °C 程度の低温熱処理を加えることが好ましい。

これに対し、低炭素濃度 (0.1 p p m a) および高窒素濃度 1×10^{14} 個 / cm^3 の結晶では、十分な BMD 密度 (10^9 台) を得るためにには初期酸素濃度を 15 p p m a 未満に下げられないため、結局 2 次 25 欠陥が発生する結果となった。

そして、高炭素濃度 (1.0 p p m a) および低窒素濃度 (5×10^{13} 個 / cm^3) の場合は、得られる BMD 密度に関しては、高炭素濃度の影響により初段熱処理温度の依存性が強くなり過ぎるので、初段の熱処理温度次第で BMD 密度のバラツキが大きくなってしまう。従って、

やはり窒素をある程度高くドープして高温で安定な酸素析出核を形成しておくことが望ましいということになる。

上記のように、ある程度以上の窒素（例えば 1×10^{14} 個/ cm^3 ）を加えることにより、炭素単独よりは初段熱処理温度依存性は弱まるため、初段の熱処理温度による BMD 密度のバラツキは少ない。しかし、あまり高温のプロセス熱処理を通過すると、炭素による析出促進効果が大幅に弱まってしまう。そこで、高い BMD 密度を得るためのエピ工程の温度としては、低温（1000°C以下）であることが望ましいと言える。

同様にエピタキシャル工程の前又は後に低温熱処理を加えたほうが、酸素析出核の成長又は新たな析出核が形成されるため、その後のエピ成長やその他のデバイスプロセス中の BMD 密度は高くなる。

そして、エピ前又は後に加えられる熱処理としては、このような低温熱処理に限らず、いわゆる IG 热処理（例えば、初段に 1100°C 以上の高温熱処理を含むもの）や RTA 装置（R a p i d T h e r m a l A n n e a l e r；急速加熱・急速冷却装置）による高温短時間の熱処理を適用することもできる。これらの熱処理プロセスを行えば、ウエーハ表面に発生している 2 次欠陥の低減も可能なので、炭素、窒素および酸素の濃度を広い範囲で選択することが出来るようになるという効果が得られる。

(アニールウエーハについて)

最後に、炭素と窒素をドープした結晶のアニールウエーハへの影響を調査、実験した。

アニールウエーハの場合も、基本的には上記のエピタキシャル成長用のシリコンウエーハについての調査と同様に、低炭素 + 低窒素 + 高酸素、および高炭素 + 高窒素 + 低酸素の組み合わせが高 BMD 密度および 2 次欠陥の抑制には大変有効であった。また、ウエーハ表面に 2 次欠陥が発生してもアニールによりその 2 次欠陥を消滅させることも可能であるた

め、直接エピタキシャル成長を行う場合とは異なり、低炭素+高窒素+高酸素、および高炭素+高窒素+高酸素の組み合わせでも十分に高密度のBMDを有し、ウエーハ表面に欠陥が少ないアニールウエーハが得られることがわかった。さらに、このようなアニールウエーハであれば、
5 エピタキシャル層を形成してもエピ層に欠陥を発生させることもないし、十分なBMD密度も得られることがわかった。

なお、炭素の特性を生かすために、低温熱処理を加えたり、アニール中の昇温速度を $5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 以下に抑えることにより、析出核を増加させることもでき、これらにより、 $800^{\circ}\text{C}/4\text{hr} + 1000^{\circ}\text{C}/16\text{hr}$
10 後の観察で 10^9 台後半から 10^{10} 台のBMD密度を確保することが出来た。

以上のように、炭素と窒素を両方ドープすることにより、炭素と窒素のそれぞれの欠点を打ち消すように働かせることが出来るので、炭素のみ、窒素のみよりも、様々なデバイスプロセスに対して、十分なBMD
15 密度を稼ぐことが出来る。

表1は、エピタキシャルウエーハとアニールウエーハに用いられる窒素および炭素がドープされたウエーハについての上記実験結果をまとめたものである。

表 1

炭素濃度		低 (0.1ppma)				高 (1.0ppma)			
窒素濃度		低 (5E13個/cm³)		高 (1E14個/cm³)		低 (5E13個/cm³)		高 (1E14個/cm³)	
酸素濃度		低 <15ppma	高 ≥15ppma	低 <15ppma	高 ≥15ppma	低 <15ppma	高 ≥15ppma	低 <15ppma	高 ≥15ppma
2次欠陥		発生せず	発生せず	発生せず	発生	発生せず	発生せず	発生せず	発生
BMD 密度	小 <1E9/cm³	大 ≥1E9/cm³	小 <1E9/cm³	大 ≥1E9/cm³	熱処理依 存性大	熱処理依 存性大	大 ≥1E9/cm³	大 ≥1E9/cm³	
エビ成長 用	不適	適	不適	不適	低温熱処 理追加に より、適	低温熱処 理追加に より、適	適	不適	
アニール 用	不適	適	不適	適 (アニー ルにより 2次欠陥 消滅可)	低温熱処 理追加に より、適	低温熱処 理追加に より、適	適	適 (アニー ルにより 2次欠陥 消滅可)	

15

なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。

例えば、上記実施形態においては、直径 8 インチのシリコン単結晶を育成する場合につき例を挙げて説明したが、本発明はこれには限定されず、直径 6 インチ以下、直径 10 ~ 16 インチあるいはそれ以上のシリコン単結晶にも適用できる。

請求の範囲

1. チョクラルスキー法によりシリコン単結晶を育成する際に、炭素をドープし、 V/G (V : 結晶引上げ速度、 G : 結晶固液界面における結晶軸方向温度勾配) を結晶全面がN-領域となるように制御しながら結晶を引上げることを特徴とするシリコン単結晶の製造方法。
5
2. 前記CZシリコン単結晶育成時に、炭素とともに窒素をドープすることを特徴とする請求項1に記載したシリコン単結晶の製造方法。
10
3. 前記ドープする炭素濃度を0.1 ppm以上とし、 V/G を $0.183 \sim 0.177 \text{ mm}^2/\text{K} \cdot \text{min}$ の範囲内で制御しながら引上げることを特徴とする請求項1または請求項2に記載したシリコン単結晶の製造方法。
15
4. 請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載された方法により製造されたシリコン単結晶をウェーハに加工した後、 $600 \sim 1000^\circ\text{C}$ の温度で熱処理を施すことを特徴とするシリコンウェーハの製造方法。
20
5. 炭素を0.1 ppm以上含有し、全面N-領域からなることを特徴とするシリコンウェーハ。
25
6. 窒素を 1×10^{18} 個/ cm^3 以上含有することを特徴とする請求項5に記載したシリコンウェーハ。
7. CZシリコン単結晶育成時に炭素および窒素をドープして引上げられたCZシリコン単結晶から作製されたシリコンウェーハ表面にエピタキシャル層を形成するシリコンエピタキシャルウェーハの製造方法

において、前記 C Z シリコン単結晶の炭素濃度、窒素濃度、酸素濃度がそれぞれ $0.1 \sim 1 \text{ p.p.m.a}$ 、 $1 \times 10^{13} \sim 1 \times 10^{14}$ 個/ cm^3 、 $15 \sim 25 \text{ p.p.m.a}$ 、または、それぞれ $1 \sim 3 \text{ p.p.m.a}$ 、 $1 \times 10^{14} \sim 5 \times 10^{15}$ 個/ cm^3 、 $10 \sim 15 \text{ p.p.m.a}$ となるように前記 C Z シリコン単結晶を引上げることを特徴とするシリコンエピタキシャルウェーハの製造方法。

8. 請求項 7 に記載のシリコンエピタキシャルウェーハの製造方法であって、前記 C Z シリコン単結晶を 2 次欠陥が発生しないように引上げることを特徴とするシリコンエピタキシャルウェーハの製造方法。

9. C Z シリコン単結晶育成時に炭素および窒素をドープして引上げられた C Z シリコン単結晶から作製されたシリコンウェーハ表面に、エピタキシャル層を形成したシリコンエピタキシャルウェーハであって、前記シリコンウェーハ中の炭素濃度、窒素濃度、酸素濃度がそれぞれ $0.1 \sim 1 \text{ p.p.m.a}$ 、 $1 \times 10^{13} \sim 1 \times 10^{14}$ 個/ cm^3 、 $15 \sim 25 \text{ p.p.m.a}$ 、または、それぞれ $1 \sim 3 \text{ p.p.m.a}$ 、 $1 \times 10^{14} \sim 5 \times 10^{15}$ 個/ cm^3 、 $10 \sim 15 \text{ p.p.m.a}$ であることを特徴とするシリコンエピタキシャルウェーハ。

20

10. 請求項 9 に記載のシリコンエピタキシャルウェーハであって、前記窒素ドープして引上げられた C Z シリコン単結晶から作製されたシリコンウェーハ中に 2 次欠陥がないことを特徴とするシリコンエピタキシャルウェーハ。

25

11. C Z シリコン単結晶育成時に炭素および窒素をドープして引上げられた C Z シリコン単結晶から作製された C Z シリコンウェーハに熱処理を行うことにより、該 C Z シリコンウェーハの表層部に無欠陥層を形成し、バルク部に 1×10^9 個/ cm^3 以上の酸素析出物を有するア

5 アニールウェーハの製造方法において、前記CZシリコン単結晶の炭素濃度、窒素濃度、酸素濃度がそれぞれ、0.1~1 p.p.m.a、 1×10^{13} ~ 1×10^{14} 個/ cm^3 、15~25 p.p.m.a、または、それぞれ1~3 p.p.m.a、 1×10^{14} ~ 5×10^{15} 個/ cm^3 、10~15 p.p.m.aとなるように前記CZシリコン単結晶を引上げることを特徴とするアニールウェーハの製造方法。

10 12. 請求項11に記載のアニールウェーハの製造方法であって、前記CZシリコン単結晶を2次欠陥が発生しないように引上げることを特徴とするアニールウェーハの製造方法。

15 13. 炭素濃度、窒素濃度、酸素濃度がそれぞれ、0.1~1 p.p.m.a、 1×10^{13} ~ 1×10^{14} 個/ cm^3 、15~25 p.p.m.a、または、それぞれ1~3 p.p.m.a、 1×10^{14} ~ 5×10^{15} 個/ cm^3 、10~15 p.p.m.aであるCZシリコンウェーハに熱処理を施したアニールウェーハであって、バルク部のBMD密度が 1×10^9 個/ cm^3 以上であることを特徴とするアニールウェーハ。

20 14. 請求項13に記載のアニールウェーハであって、ウェーハ中に2次欠陥がないことを特徴とするアニールウェーハ。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/JP01/03101

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C30B29/06, H01L21/20, 21/205, 21/322

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C30B29/06, H01L21/20, 21/205, 21/322

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1926-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2001
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2001	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2001

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
CAS ONLINE, JICST FILE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	JP, 2000-344598, A (Nippon Steel Corporation), 12 December, 2000 (12.12.00), Claims 1 to 7 (Family: none)	1-14
EX	JP, 2001-102385, A (Mitsubishi Materials Silicon Corporation), 13 April, 2001 (13.04.01), Claim 1; Par. Nos. [0018], [0024]; table 1; Figs. 1, 3 (Family: none)	1, 3-5
A	TAKEDA R. et al., "Dissolution behavior of COP in hydrogen annealed wafer I. Effect of COP size", 2000nen Shunki Dai 47kai, Ouyou Butsurigaku Kankei Rengou Kouenkai Kouen Yokoushuu, Separate Vol. 1, 28 March, 2000 (28.03.2000), page 432, 30p-YM-9	1, 3-5

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
26 June, 2001 (26.06.01)Date of mailing of the international search report
03 July, 2001 (03.07.01)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

1960 - October 10 - 1960

1000 ft.

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/03101

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(I.P.C.))

Int. C1.7 C30B29/06, H01L21/20, 21/205, 21/322

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(I.P.C.))

Int. C1.7 C30B29/06, H01L21/20, 21/205, 21/322

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1926-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2001年
日本国登録実用新案公報	1994-2001年
日本国実用新案登録公報	1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CAS ONLINE, JICST科学技術文献ファイル

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
PX	JP, 2000-344598, A(新日本製鐵株式会社), 12.12月.2000(12.12.00), 請求項1-7(ファミリーなし)	1-14
EX	JP, 2001-102385, A(三菱マテリアルシリコン株式会社), 13.4月.2001(13.04.01), 請求項1, 【0018】., 【0024】., 表1, 図1, 図3(ファミリーなし)	1, 3-5
A	TAKEDA R. et al., "Dissolution behavior of COP in hydrogen annealed wafer I. Effect of COP size," 2000年春季第47回応用 物理学関係連合講演会講演予稿集第1分冊, 2000年3月28日, p. 432, 30p-YM-9	1, 3-5

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

26.06.01

国際調査報告の発送日

03.07.01

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

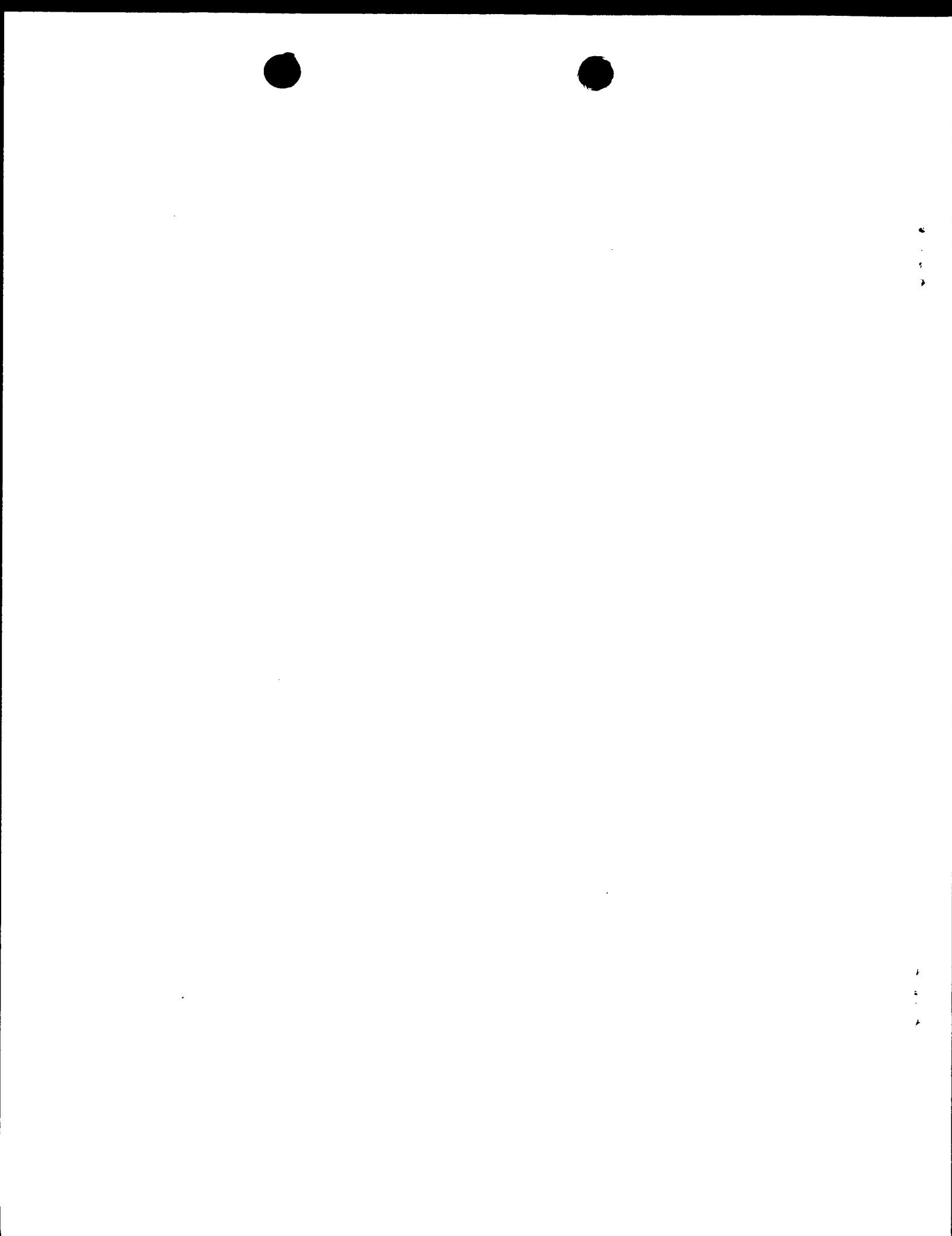
特許庁審査官(権限のある職員)

五十嵐毅



4G 9440

電話番号 03-3581-1101 内線 3416



特許協力条約

PCT

E.P. U.S.

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)
〔PCT18条、PCT規則43、44〕

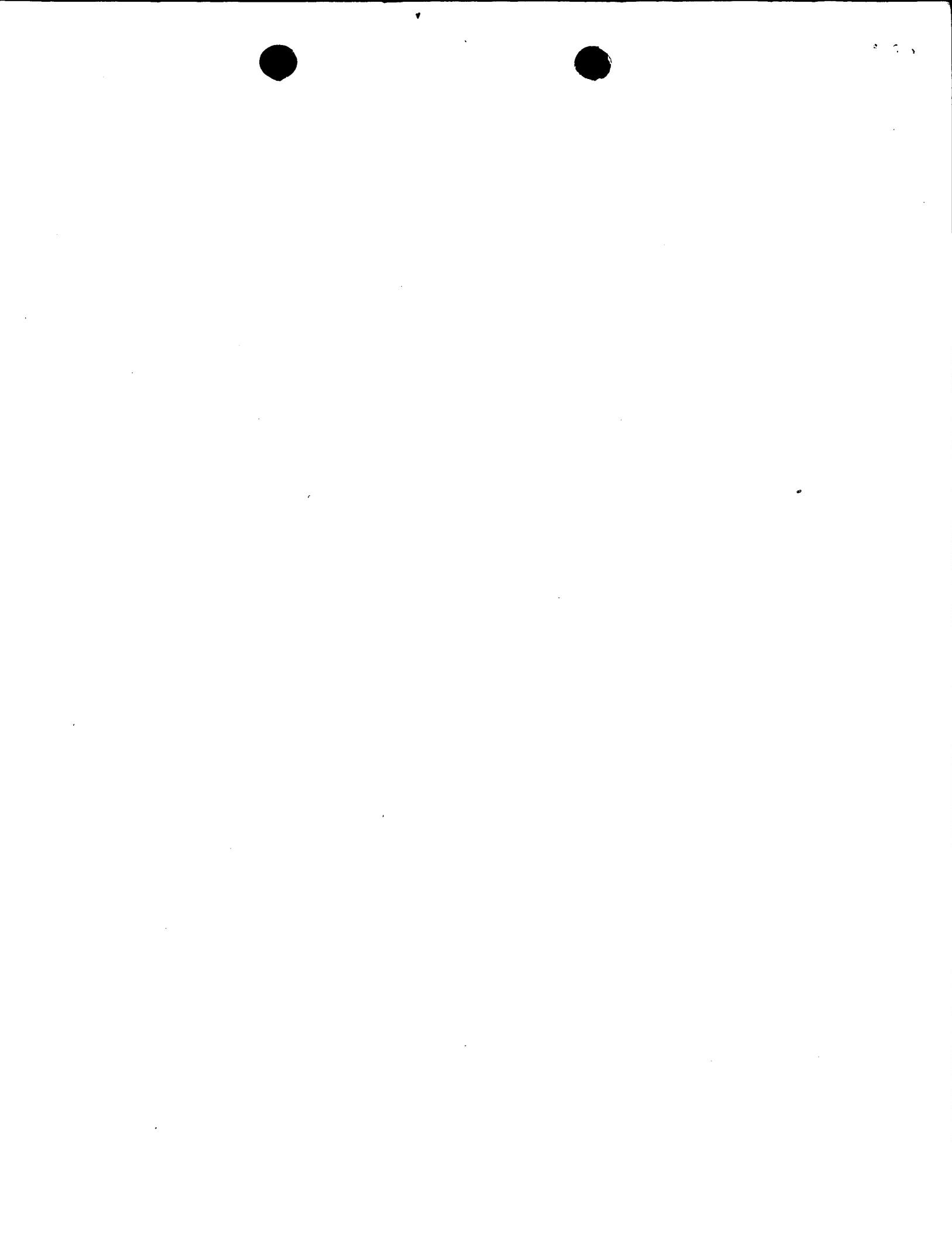
出願人又は代理人 の書類記号 99 00161WO	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JPO1/03101	国際出願日 (日.月.年)	10.04.01	優先日 (日.月.年)
出願人(氏名又は名称) 信越半導体株式会社			

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 2 ページである。 この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。
 この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。
 この国際出願に含まれる書面による配列表 この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。2. 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。3. 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。4. 発明の名称は 出願人が提出したものと承認する。 次に示すように国際調査機関が作成した。5. 要約は 出願人が提出したものと承認する。 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1ヶ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。6. 要約書とともに公表される図は、
第 _____ 図とする。 出願人が示したとおりである。 なし 出願人は図を示さなかった。 本図は発明の特徴を一層よく表している。



A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. C30B 29/06,
H01L 21/20, 21/205, 21/322

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. C30B 29/06,
H01L 21/20, 21/205, 21/322

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1926-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2001年
日本国登録実用新案公報	1994-2001年
日本国実用新案登録公報	1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CAS ONLINE, JICST科学技術文献ファイル

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
PX	JP, 2000-344598, A(新日本製鐵株式会社), 12.12月.2000(12.12.00), 請求項1-7(ファミリーなし)	1-14
EX	JP, 2001-102385, A(三菱マテリアルシリコン株式会社), 13.4月.2001(13.04.01), 請求項1, 【0018】., 【0024】., 表1, 図1, 図3(ファミリーなし)	1, 3-5
A	TAKEDA R. et al., "Dissolution behavior of COP in hydrogen annealed wafer I. Effect of COP size," 2000年春季第47回応用 物理学関係連合講演会講演予稿集第1分冊, 2000年3月28日, p. 432, 30p-YM-9	1, 3-5

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
もの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日
以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する
文献(理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

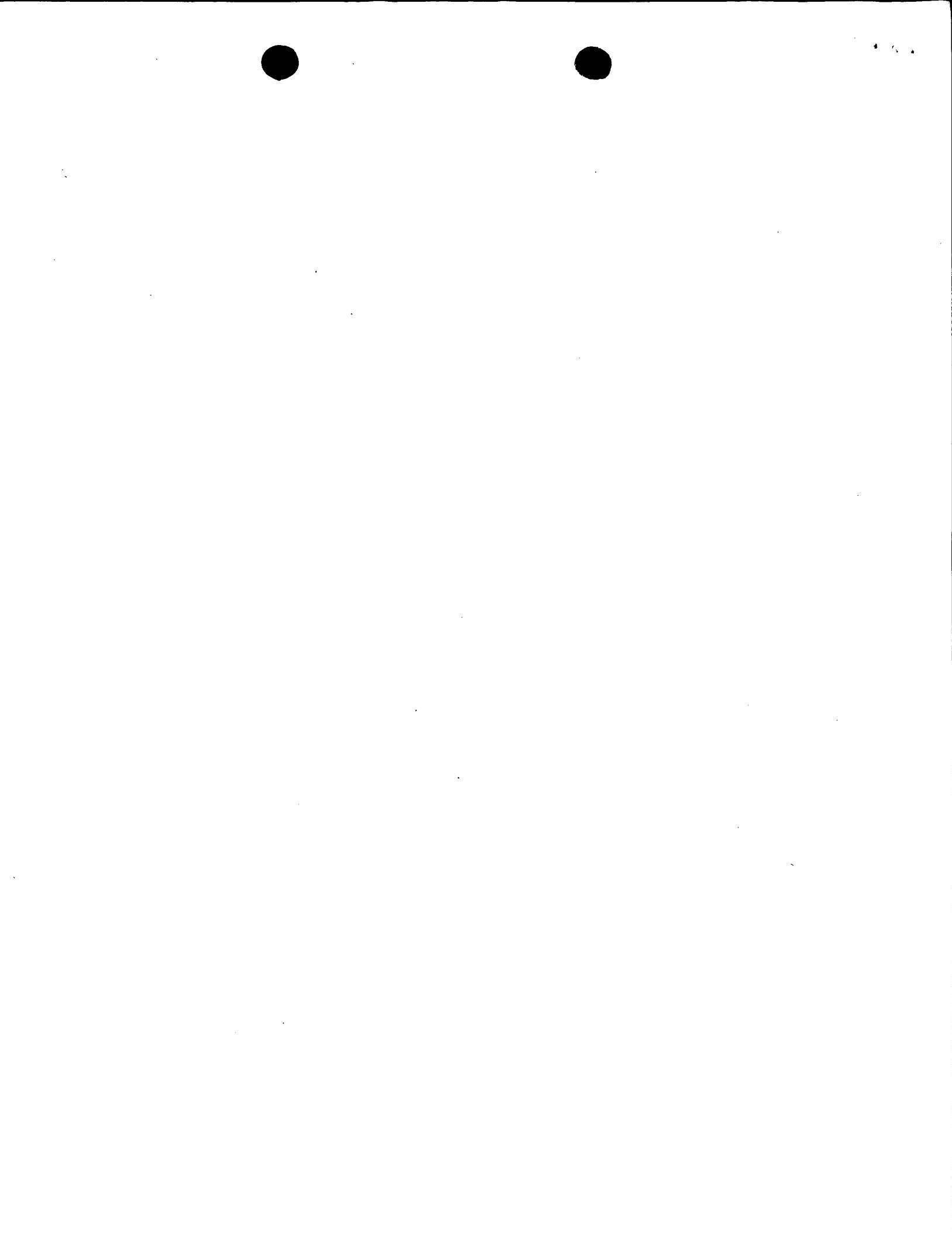
「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって
出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論
の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明
の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以
上の文献との、当業者にとって自明である組合せに
よって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 26.06.01	国際調査報告の発送日 03.07.01
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 五十嵐毅 4G 9440
	電話番号 03-3581-1101 内線 3416



30p-YM-8

RTA 处理が Si ウエーハ中の酸素析出挙動に与える影響
 Effect of Rapid Thermal Annealing on Oxide Precipitation Behavior in Silicon Wafers
 住友金属工業(株)総合技術研究所 ○赤塚雅則、奥井正彦、末岡浩治
 Sumitomo Metal Ind. Ltd. Corporate R&D Labs. ○M.Akatsuka, M.Okui and K.Sueoka
 E-mail: akatsuka-msn@aw.sumikin.co.jp

【はじめに】Si ウエーハに高温で Rapid Thermal Annealing (RTA) を施すと、空孔が過剰に凍結され、続く熱処理で酸素析出が促進される。RTA 後の析出挙動は処理雰囲気に依存することが報告されている[1]。しかしながら、処理温度、冷却速度を系統的に変化させたときの析出挙動については報告が少ない。そこで本実験では RTA 処理条件変更時の析出挙動を詳細に調査した。

【方法】200mm 径 CZ-ミラボリューム([O]_i=14×10¹⁷/cm³(old ASTM))を用意した。RTA 処理(Ar 雰囲気)における①保持温度を 1280-1200°C、②保持時間 60-300sec、③700°Cまでの冷却速度を 70-5°C/sec で、系統的に変化させた。続いて Ar 雰囲気中で 800°C/4h+1000°C/16h の析出処理を施した。最後に 2min の Wright エッチングで析出物を顕在化し、光学顕微鏡で析出物のウエーハ深さ方向分布を測定した。

【結果と考察】1280°Cで保持したときの析出物の深さ方向分布を図に示す。これより、①冷却速度が 25°C/sec 以上で析出物が観測され、冷却速度の増加とともにその密度は増加した。②表面から約 40μm の深さまで DZ 層が形成されていた。③50°C/sec 以上の冷却速度で析出物分布が M 字型となっていた。SIMS 測定では酸素外方拡散層の幅は約 20μm 以下であったことから、DZ 層幅は酸素濃度ではなく、RTA で形成された点欠陥濃度分布に依存すると推定される。M 字型分布には、点欠陥の熱平衡濃度および拡散定数の間に、 $>C_i$ および $D_v < D_i$ (V: 空孔, I: 格子間 Si)なる関係がある。^[1]竹野他: 1999 年秋季応用物理学会 2p-S-4.

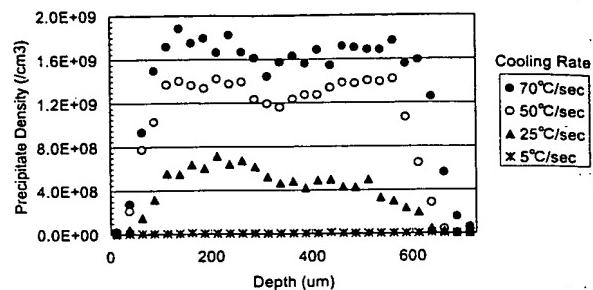


図. RTA(1280°C)→2段熟処理後の析出物の
ウエーハ深さ方向分布

30p-YM-9

高温水素アニールによるCOPの消滅挙動 I. COPサイズの影響

Dissolution Behavior of COP in Hydrogen Annealed Wafer I. Effect of COP Size
 東芝セラミックス(株)シリコン事業部製造技術部 ○竹田隆二 齋藤広幸 南俊郎 平野由美子
 Toshiba Ceramics Co.,Ltd. Silicon division, R.Takeda, H.Saito, T.Minami, Y.Hirano
 e-mail: ryuji@tocera.co.jp

目的 CZ-Si 結晶を H₂ アニールすることにより、ボイド状 grown-in 欠陥(COP)が消滅することは良く知られている。本報告では、熟履歴の違いや炭素や窒素などの不純物の混入により COP サイズが異なる結晶をアニールした場合、そのサイズが消滅挙動に及ぼす影響について考察した。

方法 COP サイズが異なるよう引上速度を変えた不純物をドープしていない結晶と、窒素あるいは炭素をそれぞれ 3~9E14、5~30E16 atoms/cm³ ドープした結晶(P 型も B 型)を、水素雰囲気中で 1200°C 1h アニールした。アニール前後のウエーハの COP 密度及びサイズ(400nm 加工後剥離し測定)を、SC-1 洗浄+バーチカル測定(Tencor SURFSCAN-6200)により評価した。

結果 図1に引上速度を変えたノンドープ結晶及び窒素、炭素ドープ結晶の COP サイズ分布を示した。引上速度を変えることで COP サイズは小さくなるが、窒素や炭素を添加することでより小サイズ化できることが確認された。図2に水素雰囲気 1h アニールで消滅した、COP サイズの臨界値をプロットした。結晶の熟履歴の制御あるいは不純物の添加のどちらにおいても、COP 密度によらず COP サイズが一定値以下であれば水素アニールにより消滅することが明らかになった。この結果から、窒素ドープのアニールによる COP 低減効果は COP 小サイズ化によることが推測された。

1) 下井他: '98 春期応物予稿 28p-PB-20

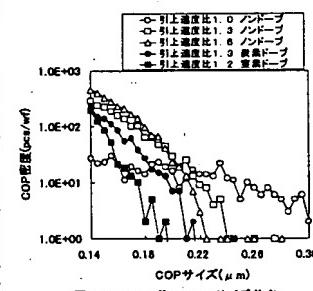


図1 アニール前のCOPサイズ分布

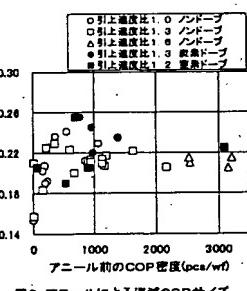


図2 アニールによる消滅COPサイズ

30p-YM-10

高温水素アニールによるCOPの消滅挙動 II. ウエーハ表層の評価

Dissolution Behavior of COP in Hydrogen Annealed Wafer II. Investigation of Near Surface Region
 東芝セラミックス(株)、(株)東芝セミコンダクター社 ○南俊郎 平野由美子 竹田隆二 新田伸一
 Toshiba Ceramics Co.,Ltd, Toshiba Semiconductor Corp. *, T.Minami, Y.Hirano, R.Takeda, S.Nitta
 e-mail: minami@tocera.co.jp

目的 不純物の添加や引上時の熟履歴を変えることで CZ-Si 結晶中の COP サイズが小さくなり、H₂ アニールすると極表層の欠陥が消滅しやすくなることを報告した。本報告では H₂ 雰囲気でアニールしたときの接合リーキ評価、表層の欠陥密度及び GOI 評価を行った。

方法 COP サイズの異なる結晶を水素雰囲気 1200°C で熟処理後、接合リーキ電流測定を行った。また表面から約 12μm 研磨し、可視光散乱トポグラフィ(LSTD scanner MO-601)による極表層(表面~1μm 相当)LSTD 密度及び GOI 評価を行った。

結果 COP サイズの小さい結晶を H₂ 雰囲気でアニールすることにより、接合リーキ不良率は Epil 並に低減され、リーキセル数と LSTD 密度との間に相関が認められた。また図1のようにより深い部分まで LSTD 密度が低減している事が確認できた。深さ 12μm 研磨後の酸化膜耐圧測定結果も LSTD 密度の傾向と一致した(図2)。アニール時間が長いほど深い部分の欠陥は低減しており、COP サイズを制御することがより深い領域の完全性向上に効果的であることがわかった。

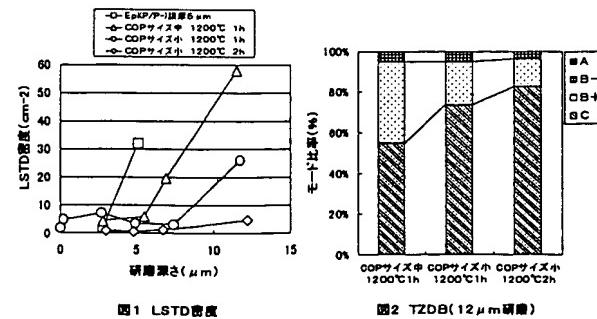


図1 LSTD密度

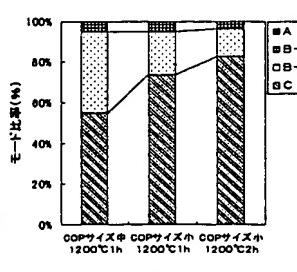
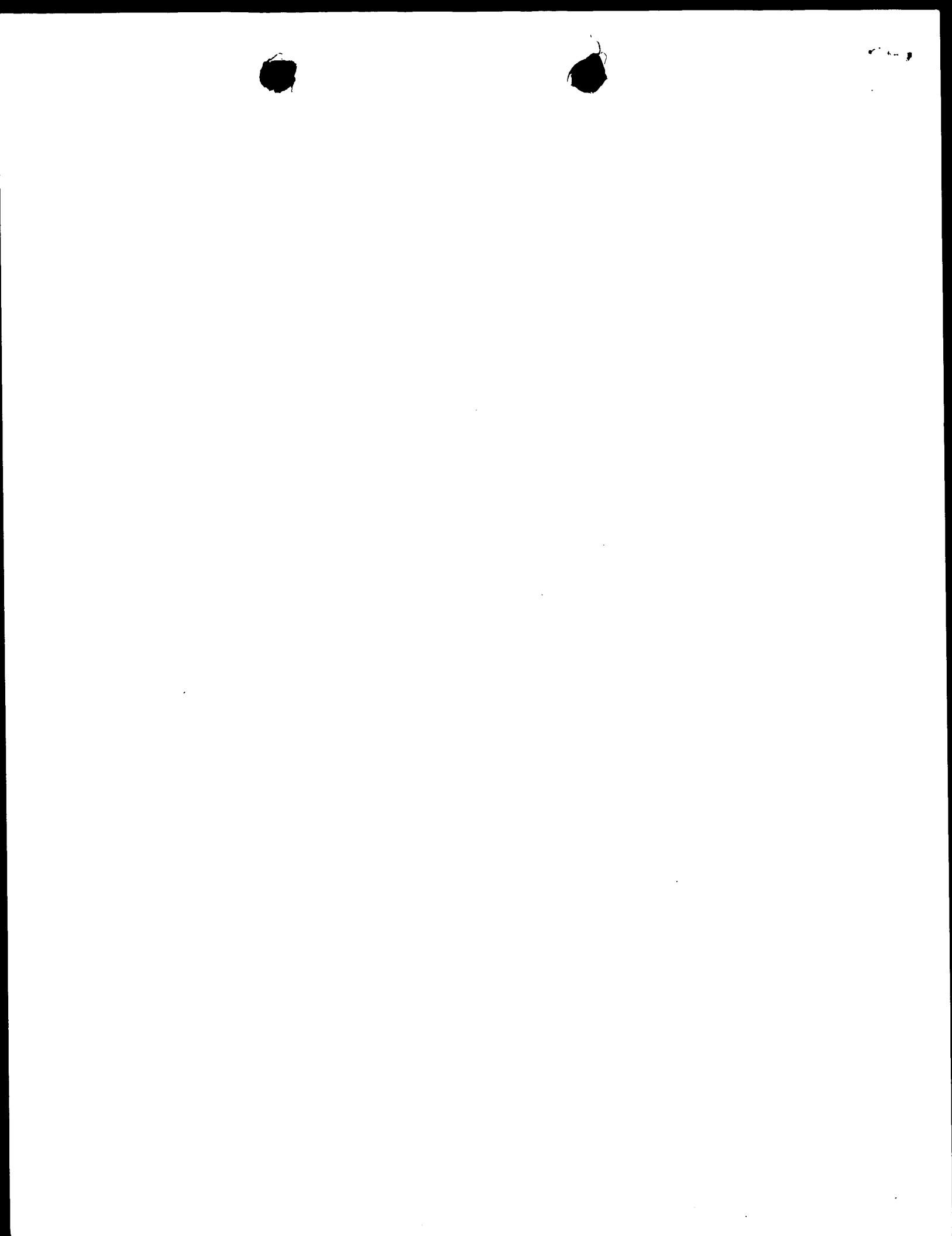


図2 TZDB (12μm 研磨)



2000年（平成12年）春季
第47回応用物理学関係連合講演会講演予稿集
第1分冊

Extended Abstracts (The 47th Spring Meeting, 2000);
The Japan Society of Applied Physics and Related Societies
No. 1

2000年3月28日発行

発行所：(社)応用物理学学会
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-12-3
九段北ビル 5階
TEL 03-3238-1044

